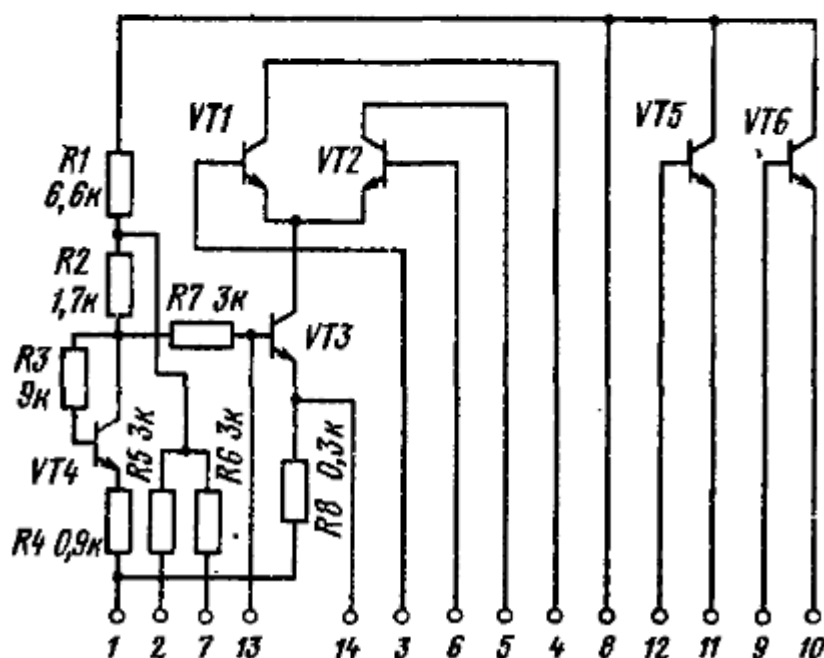


K175УВ2А, K175УВ2Б

Микросхемы представляют собой дифференциальный усилительный каскад со стабилизацией режима и двумя вспомогательными транзисторами, на которых возможно построение входных или выходных эмиттерных повторителей. Предназначены для применения в бытовой радиоэлектронной аппаратуре.

Корпус типа 401.14-4 (см. K175ДА1). Масса не более 1 г.

K175УВ2(А,Б)



Назначение выводов: 1—питание ($-U_{п}$); 2—делитель цепей смещения; 3—вход 1; 4—выход 1; 5—выход 2; 6—вход 2; 7—делитель цепей смещения; 8—питание ($+U_{п}$); 9—база 2-го вспомогательного транзистора; 10—эмиттер 2-го вспомогательного транзистора; 11—эмиттер 1-го вспомогательного транзистора; 12—база 1-го вспомогательного транзистора; 13—вход регулировки усиления; 14—фильтр.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	6 В
Ток потребления при $U_{\text{вх}}=0$, не более:	
при $U_{\text{п}}=6$ В, $T=+25^{\circ}\text{C}$	3 мА
при $U_{\text{п}}=6,6$ В, $T=-25^{\circ}\text{C}$	4 мА
Напряжение на выводах 4 и 5 при $U_{\text{п}}=6$ В, $U_{\text{вх}}=0$, $T=+25^{\circ}\text{C}$	3,6...5,2 В
Напряжение на выводах 10 и 11 при $U_{\text{п}}=6$ В, $U_{\text{вх}}=0$, $T=+25^{\circ}\text{C}$	2,1...2,4 В
Крутизна при $U_{\text{п}}=6$ В, $f=20$ МГц, $U_{\text{вх}}=10$ мВ, $T=+25^{\circ}\text{C}$, не менее	10 мА/В
Нестабильность крутизны при $U_{\text{п}}=6$ В, $f=$ $=20$ МГц, $U_{\text{вх}}=10$ мВ в диапазоне температур, не более:	
+25...+85 $^{\circ}\text{C}$	-50%
-25...+25 $^{\circ}\text{C}$	+30%
Коэффициент шума при $U_{\text{п}}=6$ В, $f=20$ МГц, $R_{\text{н}}=1$ кОм, $C_{\text{н}}=5$ пФ, $T=+25^{\circ}\text{C}$, не более	6 дБ
Верхняя граничная частота при $U_{\text{п}}=6$ В, $U_{\text{вх}}=$ $=10$ мВ, $R_{\text{н}}=1$ кОм, $C_{\text{н}}=5$ пФ, $T=+25^{\circ}\text{C}$, не менее:	
К175УВ2А	50 МГц
К175УВ2Б	65 МГц
Глубина регулировки усиления при $U_{\text{п}}=6$ В, $U_{\text{вх}}=20$ мВ, $T=+25^{\circ}\text{C}$, не менее:	
при $f=1$ МГц	60 дБ
при $f=10$ МГц	40 дБ
Коэффициент ослабления синфазного сигнала при $U_{\text{п}}=6$ В, $T=+25^{\circ}\text{C}$, не менее	60 дБ
Входное сопротивление при $U_{\text{п}}=6$ В, $f=$ $=100$ МГц, $T=+25^{\circ}\text{C}$, не менее	1 кОм

**Предельные эксплуатационные
данные**

Максимальное напряжение питания	6,6 В
Максимальное входное напряжение	± 2 В
Максимальное синфазное входное напряжение	± 3 В
Максимальное напряжение на выводах 4 и 5	9 В
Максимальный ток коллектора дополнительных транзисторов	2 мА
Максимальное обратное напряжение база — эмиттер дополнительных транзисторов ...	3 В
Максимальная рассеиваемая мощность одним дополнительным транзистором при $T = +85^\circ \text{C}$	10 мВт